

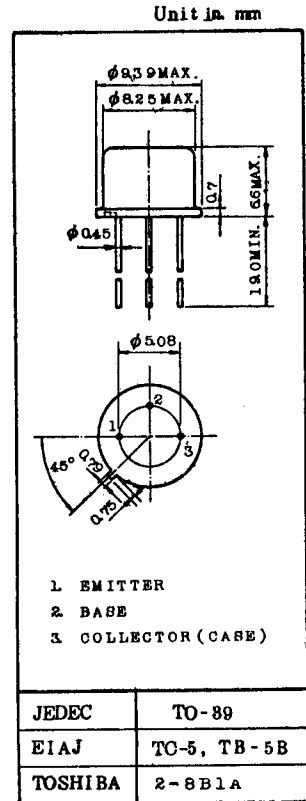
- 映像増幅用
- 高周波電力増幅用
- 高電圧スイッチング用
- Video Amplifier, High Frequency Amplifier and High Voltage Switching Applications

- ・ 高耐圧です: $V_{CBO} = 170V$
 $V_{CEO} = 120V$
- ・ 電流の伸びがよい: $I_C = 100mA$ (Max.)
- ・ トランジション周波数が高い: $f_T = 250MHz$ (Typ.)
- ・ C_{ob} が小さい: $C_{ob} = 2.8 pF$ (Typ.)

通信工業用
INDUSTRIAL APPLICATIONS

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT.	
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	170	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	120	V	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V	
コレクタ電流	I_C	100	mA	
エミッタ電流	I_E	-100	mA	
コレクタ損失	P_C	$T_a = 25^\circ C$	750	mW
		$T_c = 25^\circ C$	2.8	W
接合温度	T_j	175	$^\circ C$	
保存温度	T_{stg}	-65~175	$^\circ C$	



※ PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

2SC507

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

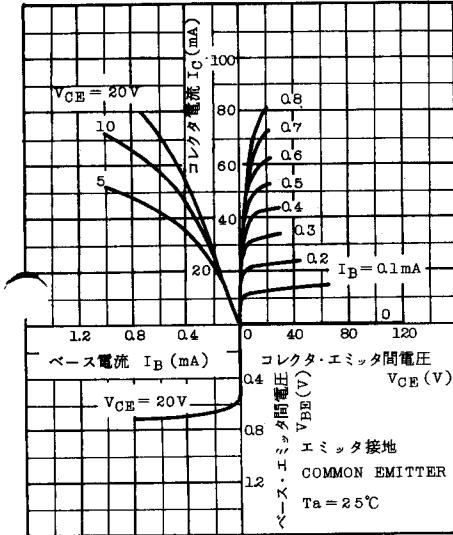
CHARACTERISTIC		SIMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流		I_{CBO}	$V_{CB} = 100V, I_E = 0$	—	—	0.5	μA
エミッタシャ断電流		I_{EBO}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	1.0	μA
コレクタ・ベース間降伏電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C = 0.1mA, I_E = 0$	170	—	—	V
コレクタ・エミッタ間降伏電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 1mA, I_B = 0$	120	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 0.1mA, I_C = 0$	5	—	—	V
直流電流増幅率 (Note)		h_{FE}	$V_{CE} = 5V, I_C = 10mA$	40	70	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C = 10mA, I_B = 1mA$	—	0.4	0.8	V
ベース・エミッタ間飽和電圧		$V_{BE(sat)}$	$I_C = 10mA, I_B = 1mA$	—	0.85	1.2	V
トランジション周波数		f_T	$V_{CE} = 20V, I_E = -10mA$	100	250	—	MHz
コレクタ出力容量		C_{ob}	$V_{CB} = 20V, I_E = 0$ $f = 1MHz$	—	2.8	4.0	pF
スイッチング 時間	ターンオン時間	t_{on}	$V_{CC} = 50V, I_C = 10mA$ $I_{B1} = -I_{B2} = 1mA$	—	0.1	—	μs
	蓄積時間	t_{stg}		—	1	—	μs
	下降時間	t_f		—	0.1	—	μs

Note ; h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

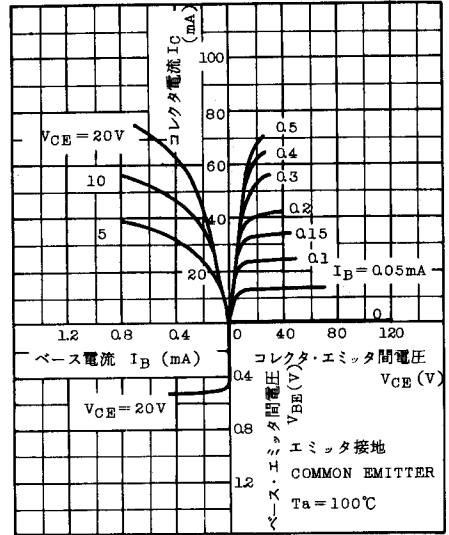
According to the value of h_{FE} , the 2SC507 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC507-R	40	80
2SC507-O	70	140
2SC507-Y	120	240

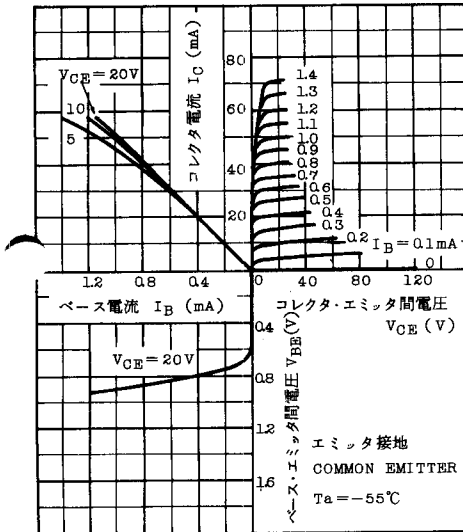
STATIC CHARACTERISTICS



STATIC CHARACTERISTICS



STATIC CHARACTERISTICS



2SC507

